

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 20 年 1 月 24 日 (2008.1.24)

【公表番号】特表 2003-515943 (P2003-515943A)
【公表日】平成 15 年 5 月 7 日 (2003.5.7)
【出願番号】特願 2001-542269 (P2001-542269)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

G 0 1 B 11/06 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/30 5 6 4 D

G 0 1 B 11/06 Z

【手続補正書】
【提出日】平成 19 年 11 月 27 日 (2007.11.27)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 2 0
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0 0 2 0】

図 3 を参照すると、光強度が最適化されると、本工程の次の手順は、ノズル 3 4 から基板 3 2 にホトレジスト材料 4 8 を施与することである。ホトレジストを施与する際には、仕様により必要とされるホトレジスト層の厚みに応じて、基板 3 2 は静止施与では静止状態にあり、動的施与では回転機構 3 3 により回転状態にある。ホトレジスト材料 4 8 が基板 3 2 に接触すると、カメラ 3 8 はこの事象を検出することになる。材料 4 8 の基板 3 2 への接触が適切な時期に検出されると、適切なホトレジストの量が確実に堆積されることになる。